

H30年8月6日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第145委員会
委員長 柿本 浩一

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会
第160回研究会 開催通知

日時：2018年10月19日(金) 13:00～17:30

会場：明治大学 駿河台キャンパス 大学会館第一、第二会議室

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

東京都千代田区神田駿河台1-1 (TEL 03-3296-4545)

JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩3分

東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩5分

都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩5分

テーマ： 「ワイドギャップ半導体 β -Ga₂O₃ 結晶育成と評価、デバイス応用の最前線」

世話人： 上田 修 (金沢工業大学)、太子敏則 (信州大学)、石川由加里 (JFCC)

プログラム案：

- | | | |
|-------------|--|---------------|
| 13:00～13:05 | 開会の挨拶 | 柿本浩一 (九州大学) |
| 13:05～13:10 | はじめに | 太子敏則 (信州大学) |
| 13:10～13:50 | 「EFG法 β -Ga ₂ O ₃ 結晶育成とデバイス応用」
佐々木公平、倉又朗人、山腰茂伸 (ノベルクリスタルテクノロジー) | |
| 13:50～14:30 | 「VB法 β -Ga ₂ O ₃ 結晶の成長・加工・評価」
大葉悦子、小林拓実、中澤みなみ、宮下忠一 (不二越機械工業)、
太子敏則、干川圭吾 (信州大学) | |
| 14:30～15:10 | 「HVPE法による β -Ga ₂ O ₃ 結晶のエピタキシャル成長」 | 熊谷義直 (東京農工大) |
| 15:10～15:25 | 休憩 | |
| 15:25～16:05 | 「 β -Ga ₂ O ₃ 結晶中の転位とエッチピットの関係」 | 姚 永昭 (JFCC) |
| 16:05～16:45 | 「 β -Ga ₂ O ₃ 結晶中の積層欠陥の評価」 | 山口博隆 (産総研) |
| 16:45～17:25 | 「 β -Ga ₂ O ₃ 結晶中の欠陥と電気的特性との関係」 | 嘉数 誠 (佐賀大学) |
| 17:25～17:30 | おわりに | 上田 修 (金沢工業大学) |
| 17:40～20:00 | 意見交換会 (明治大学 リバティータワー23階 サロン燦) | |

以上